



1. 主要特点

硅外延平面工艺

2. 封装形式 TO-220

3. 主要用途

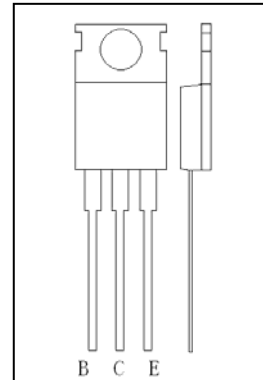
低频功率放大

电源调整

伴音、场输出

4. 和 D880 构成互补对管

5. 绝对最大额定值 $T_a=25$



项目	符号	数值	单位
集电极—基极直流电压	V_{CB0}	-120	V
集电极—发射极直流电压	V_{CEO}	-70	V
发射极—基极直流电压	V_{EBO}	-7	V
集电极直流电流	I_C	-3	A
集电极耗散功率 $T_a=25$	P_C	1.5	W
		$T_c=25$	30
最高结温	T_j	150	
贮存温度范围	T_{stg}	-55~150	

6. 电特性 $T_a=25$

项目	符号	测试条件	规范		单位
			Min	Max	
集电极—基极直流电压	BV_{CB0}	$I_C=-10\mu A$ $I_E=0$	-120		V
集电极—发射极直流电压	BV_{CEO}	$I_C=-10mA$ $I_B=0$	-70		V
发射极—基极直流电压	BV_{EBO}	$I_E=-1mA$ $I_C=0$	-7		V
集电极—基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-140V$ $I_E=0$		-100	μA
集电极—发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=-80V$ $I_B=0$		-100	μA
发射极—基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-7V$ $I_C=0$		-100	μA
集电极—发射极饱和压降	V_{CEsat}	$I_C=-3A$ $I_B=-0.3A$		-1	V
基极—发射极正向导通压降	$V_{BE(ON)}$	$I_C=-5A$ $I_B=-0.5A$		-1	V
直流电流增益	h_{FE1}	$V_{CE}=-5V$ $I_C=-0.5A$	60	300	
	h_{FE2}	$V_{CE}=-5V$ $I_C=-3A$	20		
	h_{FE3}	$V_{CE}=-5V$ $I_C=-50mA$	70		
	f_T	$V_{CE}=-5V$ $I_C=-0.5A$	5		MHz

www.DataSheet4U.com 7. h_{FE1} 分档要求 60 - 120 ; 100 - 200 ; 150 - 300

地址：广东省深圳市南山区西丽留仙洞桑泰工业园 1 栋

邮编：518055

- 1 -

电话：0755-86020755 传真：0755-86020855

网址：http://www.dayan.com.cn

2005-1-27